

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
5 août 2004 (05.08.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/066350 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ : H01L (74) Mandataire : CABINET MICHEL DE BEAUMONT, Michel; 1, rue Champollion, F-38000 GRENOBLE (FR).

(21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2004/050011 (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Date de dépôt international : 12 janvier 2004 (12.01.2004)

(25) Langue de dépôt : français (26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité : 03/00307 13 janvier 2003 (13.01.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : STMICROELECTRONICS SA [FR/FR]; 29, Boulevard Romain Rolland, F-92120 MONTROUGE (FR).

(72) Inventeur; et

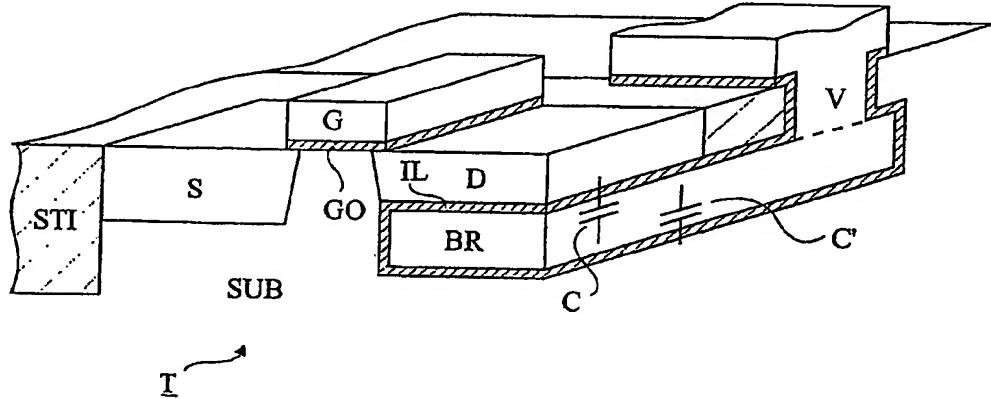
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : SCHOEL-LKOPF, Jean-Pierre [FR/FR]; 3, RUE BAYARD, F-38000 GRENOBLE (FR).

Publiée : — sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: EMBEDDED CAPACITOR ASSOCIATED WITH A SRAM CELL

(54) Titre : CONDENSATEUR ENTERRE ASSOCIE A UNE CELLULE SRAM



(57) Abstract: The invention concerns a capacitor whereof one first electrode consists of a highly doped active region (D) of a semiconductor component (T) formed on one side of a surface of a semiconductor body, and whereof the second electrode consists of a conductive region (BR) coated with insulation (IL) formed beneath said active region and embedded in the semiconductor body.

(57) Abrégé : L'invention concerne un condensateur dont une première électrode est constituée d'une région active fortement dopée (D) d'un composant semi-conducteur (T) formé du côté d'une surface d'un corps semi-conducteur, et dont la deuxième électrode est constituée d'une région conductrice (BR) enrobée d'isolant (IL) formée sous ladite région active et noyée dans le corps semi-conducteur.

WO 2004/066350 A2



En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.